












| | | |
|---|--|---|
|  | <h2 style="color: red;">IPD096N08N3GBTMA1</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | IPD096N08N3GBTMA1 |
|  | Hersteller / Marke: | International Rectifier (Infineon Technologies) |
| | Teil der Beschreibung: | MOSFET N-CH 80V 73A TO252-3 |
| | Datenblätter: |  IPD096N08N3GBTMA1.pdf |
| | RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: | New original, Stock Available. |
| | Liefern von: | Hong Kong |
| Image may be representation. See specs for product details. | Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | IPD096N08N3GBTMA1 |
| Hersteller | International Rectifier (Infineon Technologies) |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 80V 73A TO252-3 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 3.5V @ 46µA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | PG-TO252-3 |
| Serie | OptiMOS™ |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 9.6 mOhm @ 46A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 100W (Tc) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 2410pF @ 40V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 35nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 80V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 73A (Tc) |

IPD096N08N3GBTMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD096N08N3GBTMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD096N08N3GBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD096N08N3GBTMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|---|---|
| sein:  IPD09N03L I IPD09N03L I |  IPD096N08N3G INFINEON IPD096N08N3G INFINEON |  IPD096N08N3 G INFINEON IPD096N08N3 G INFINEON |  IPD09N03 Infineon IPD09N03 Infineon |
|  IPD09N03LA-G INFINEON IPD09N03LA-G INFINEON |  IPD09N03LA INFINEON IPD09N03LA INFINEON |  IPD090N03LGBTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 40A TO252 |  IPD09N03LA G Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 50A DPAK |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| IPD096N08N3GBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) | IPD096N08N3GBTMA1 Datenblatt | IPD096N08N3GBTMA1-Datenblätter | IPD096N08N3GBTMA1 PDF | International Rectifier (Infineon Technologies) IPD096N08N3GBTMA1 |
| IPD096N08N3GBTMA1 Electronic | IPD096N08N3GBTMA1-Komponenten | IPD096N08N3GBTMA1-Verteiler | IPD096N08N3GBTMA1-Bild | IPD096N08N3GBTMA1-Teil |
| IPD096N08N3GBTMA1 Preis | IPD096N08N3GBTMA1 Hersteller | IPD096N08N3GBTMA1 Bild | IPD096N08N3GBTMA1 Aktie | IPD096N08N3GBTMA1 Inventar |
| IPD096N08N3GBTMA1 Neu | IPD096N08N3GBTMA1 Original | IPD096N08N3GBTMA1 garantiert | IPD096N08N3GBTMA1 RFQ | IPD096N08N3GBTMA1 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited